

2SK3098

NチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
 - ・低Qg化。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

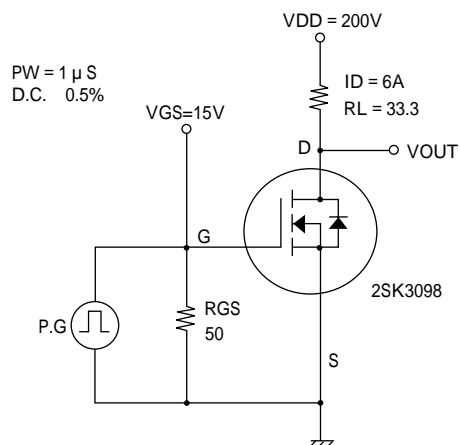
			unit
ドレイン・ソース耐圧	VDSS	400	V
ゲート・ソース耐圧	VGSS	±30	V
ドレイン電流 (DC)	ID	12	A
ドレイン電流 (パルス)	IDP	48	A
許容損失	PD (TC = 25)	85	W
チャネル温度	Tch	150	
保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 150	

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V(BR)DSS	ID = 1mA , VGS = 0	400			V
ドレイン・ソースシャ断電流	IDSS	VDS = 320V , VGS = 0			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	IGSS	VGS = ±30V , VDS = 0			±100	nA
カットオフ電圧	VGS(off)	VDS = 10V , ID = 1mA	3		4	V
順伝達アドミタンス	yfs	VDS = 10V , ID = 6A	2.9	5.8		S
飽和抵抗	RDS(on)	ID = 6A , VGS = 15V	0.43	0.55		
入力容量	Ciss	VDS = 20V , f = 1MHz	1150			pF
出力容量	Coss	VDS = 20V , f = 1MHz	350			pF
帰還容量	Crss	VDS = 20V , f = 1MHz	150			pF
ゲ - ト入力電荷量	Qg	VDS = 200V , ID = 12A VGS = 10V	40			nC
ターンオン遅延時間	td(on)	下図指定回路において	20			ns
立ち上がり時間	tr	"	35			ns
ターンオフ遅延時間	td(off)	"	85			ns
下降時間	tf	"	45			ns
ダイオード順電圧	VSD	IS = 12A , VGS = 0			1.2	V

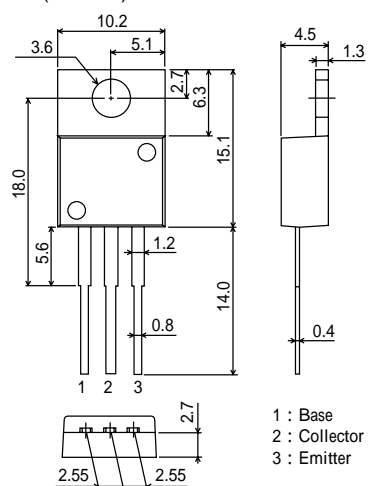
(注) ゲート・ソース間には保護ダイオードは入っていないので取り扱いには充分注意すること。

スイッチングタイム測定回路図



外形図

TO-220(unit:mm)



これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。



LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.